

Перв. примен		ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001		Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ								Документация			
				A1			ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э1	Схема электрическая	1		
								структурная			
				A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э3	Схема электрическая	1		
								принципиальная			
				A4			ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 ПЭ 3	Перечень элементов	1		
				A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СБ	Сборочный чертёж	1		
				A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э0	Измерительный стенд	1		
							ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 ПД1	Сравнение моделирования	1		
								и экспериментальных данных			
Подп. и дата								Детали			
				A3		1	ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.002	Плата печатная	1		
						2		Радиаторы для VT1, VT4	2		
						3		Радиатор для VT5	1		
								Конденсаторы			
						4		Конденсатор электролитический	2	C1, C12	
								K50-35 220мкФ 100В (Jamicon, США)			
						5		Конденсатор плёночный	2	C2, C13	
								CL21, 1мкФ 63В (Китай)			
		6		Конденсатор керамический K10-17Б	1	C3					
				имп., 220нФ, 50В (Китай)							
		7		Конденсатор электролитический	1	C4					
				220мкФ, 50В (EPCOS, Германия)							
Инв. Н дубл.								ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001			
				Изм	лист	Н докум.	Подпись				Дата
				Разраб.	Дорунц Ш.А.						
Инв. Н подл.								Усилитель низких частот Спецификация	Лит.	Лист	Листов
							1		2		
				МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-53Б							
	Н. контр.										
	Утв.										

ИУ 4.11.03.	Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Сп			8		Конденсатор керамический К10-17Б	1	С5
					имп., 470нФ, 50В (Китай)		
			9		Конденсатор электролитический	2	С6, С11
					К50-6, 10мкФ, 25В (Jamicon, США)		
			10		Конденсатор керамический К10-17Б	1	С7
					имп., 220нФ, 50В (Китай)		
			11		Конденсатор пленочный	1	С8
					CL21, 100нФ, 100В (Китай)		
			12		Конденсатор керамический К10-17Б	1	С9
					имп., 100нФ, 100В (Китай)		
			13		Конденсатор электролитический	1	С10
					К50-35, 470мкФ 10В (Jamicon, США)		
Подп. и дата							
					<u>Разъёмы</u>		
			16		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Китай)	1	XS1
			17		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-02P (Degson, Китай)	1	XS2
			18		Гнездо стерео 3.5мм ST-025	1	XS3
					(Dragon City Industries, Китай)		
Инв. N дубл.							
					<u>Диоды</u>		
			19		ZPD12-DIO (Diotec Semiconductor, Германия)	1	VD1
			20		1N4007 (Diotec Semiconductor, Германия)	4	VD2, VD3, VD4, VD5
Взам. инв. N							
					<u>Резисторы</u>		
			19		CF-100 1Вт 2,2кОм 5%	1	R1
			20		CF-100 1Вт 1кОм 5%	2	R2, R3
			21		SQP 5Вт 0.22Ом 5%	2	R4, R6
Подп. и дата							
Инв. N							
ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001							лист
							2
Из	лист	N докум.	Подпись	Дата			

Перв. примен		ИУ 4.11.03.03.23.05.52.09.001		Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ						22			CF-25 0,25Вт 2,7кОм 5%	1	R5
						23			CF-25 0,25Вт 8,2кОм 5%	1	R7
						24			CF-25 0,25Вт 22кОм 5%	1	R8
						25			МО-200 2Вт 10м 5%	1	R9
						26			SQP 10Вт 0.33Ом 5%	1	R10
						27			CF-25 0,25Вт 100Ом 5%	1	R11
						28			CF-25 0,25Вт 750Ом 5%	1	R12
						29			CF-25 0,25Вт 3Ом 5%	1	R13
						28			CF-25 0,25Вт 750Ом 5%	1	R12
						29			CF-25 0,25Вт 3Ом 5%	1	R13
						30			TIP142 (STMicroelectronics, Франция)	1	VT1
						31			BC556B (Diotec Semiconductor, Германия)	2	VT2, VT3
						33			TIP147 (STMicroelectronics, Франция)	1	VT4
						34			BD241C (STMicroelectronics, Франция)	1	VT5
Подп. и дата											
Инв. N											
									ИУ 4.11.03.03.23.05.52.09.001		
									лист		
Из	лист	N докум.		Подпись	Дата						3